

世界知的所有権機関 際事務

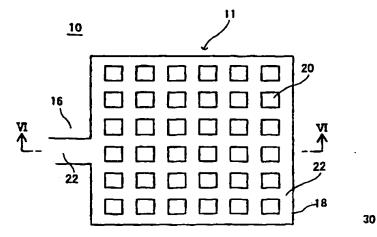
特許協力条約に基づいて公開された国際出願



(51) 国際特許分類6 WO99/38204 (11) 国際公開番号 A1 H01L 21/3205 (43) 国際公開日 1999年7月29日(29.07.99) (21) 国際出願番号 PCT/JP99/00225 (81) 指定国 JP, KR, US, 欧州特許 (DE, FR, GB) 添付公開書類 (22) 国際出願日 1999年1月22日(22.01.99) 国際調査報告書 (30) 優先権データ 特願平10/11354 1998年1月23日(23.01.98) JP (71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) ローム株式会社(ROHM CO., LTD.)[JP/JP] 〒615-0045 京都府京都市右京区西院溝崎町21 Kyoto, (JP) (72) 発明者;および (75) 発明者/出願人(米国についてのみ) '」本浩史(YAMAMOTO, Koji)[JP/JP] 派本信久(KUMAMOTO, Nobuhisa)[JP/JP] 松本宗之(MATSUMOTO, Muncyuki)[JP/JP] 〒615-0045 京都府京都市右京区西院溝崎町21 ローム株式会社内 Kvoto, (JP) (74) 代理人 弁理士 山田義人(YAMADA, Yoshito) 〒541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町2-6-6 タナベビル Osaka, (JP)

DAMASCENE INTERCONNECTION AND SEMICONDUCTOR DEVICE (54)Title:

(54)発明の名称 ダマシン配線および半導体装置



(57) Abstract

A semiconductor device comprising an insulating layer, interconnection grooves formed in the insulating layer and communicating with a semiconductor chip, and pad grooves communicating with the interconnection grooves. The pad grooves include projections formed by leaving part of the insulating layer unremoved. After conductor layer is formed on the insulating layer, including in the interconnection grooves and the pad grooves, the conductor layer is removed by a CMP technique, while the projections serve to prevent the conductor layer in the pad grooves from being overpolished.

半導体装置は、絶縁膜を含み、この絶縁膜上に、半導体素子に通じる配線溝、 およびその配線溝に通じるパッド溝が形成される。パッド溝中には、絶縁膜の一 部を残すことによって、突起が形成される。配線溝およびパッド溝を含んで絶縁 膜上に導電膜を形成した後、CMP法によって、その導電膜が除去される。この とき、突起がパッド蓆内の導電膜がオーバーポリッシュされるのを防止する。

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

ΑE AM A T UNABBERG JRY ARGH-MNUYNEK スイス コートジボアール カメルーン 中国 キューバキブロス チェッコ K R K Z L C

スペインン ペインライン ガラボン 英国 ナゲア グルーチア ES FI FR ABDUDUGUGH CGGGGGGGGGH ガギギギクハイアイイアイ日ケキ北岐カセーンニニリョンンイスンイタ本ニル朝国ザンアニアシアガドルラドスリ アギ蛀 フトビアアシアル ン タ タシビ アーシンル ン タ タシップ ド ド ン ンアサ アド ド ン ンアオ HILLITITICA

リヒテ・リンシュタ マリンシンカ リンシン リントア リントアニアブル リントでブイ アプロング マープロング マープロング TULLUM: モナコ モルドヴァ マダガスカル マ<u>ケド</u>ニア旧ニーコスラヴィア MK 共和国 MMMMMNNNNPPRR

・・・デン

SKSL SZ TTTTTTUUUUVY

シンガボール

明細書

ダマシン配線および半導体装置

技術分野

この発明はダマシン配線および半導体装置に関する。より詳細には、この発明は、ポンディングパッドをパッド溝およびそのパッド溝に埋め込んだ金属膜ないし導電膜によって形成した、ダマシン配線およびそれを用いる半導体装置に関する。

従来技術

近年では、半導体装置における配線を多層化する際に、金属膜ないし導電膜を 絶縁膜に埋め込む、いわゆるダマシン(damascene)法が採用されつつある。

一般的なダマシン配線では、簡単に説明すると、図1 (a) に示すように半導体基板1上に形成された絶縁膜2を、図1 (b) に示すように、配線に対応するようパターニングされたレジスト3をマスクとしてエッチングして、溝4を形成する。続いて、レジスト3を除去した後、図1 (c) に示すように、溝4を覆うようにして導電膜5を形成する。そして、図1 (d) に示すように、たとえば化学機械的研磨法 (Chemical Mechanical Polish Method:以下、「CMP法」という。) 等を用いた研磨工程において、溝4以外の部分の導電膜5を除去する。

導電膜5をCMP法によって除去する場合には、図2に示すように、溝の開口面積が大きいほど溝に埋め込まれた導電膜の研磨レートが大きくなることが知られている。したがって、一般配線のように溝の開口面積が小さい部分では特に問題は生じないが、図3に示すポンディングパッド6のように溝の開口面積が大きい部分では、図4に示すように、溝中の導電膜5が研磨材によって皿状に削られてしまい、いわゆるディッシング(dishing)を生じる。そのために、ポンディングパッドとICフレームとの接続時に、肉厚が薄くなった中央部Aにおいて、断線や抵抗値の上昇が生じることがあった。

発明の概要

それゆえに、この発明の主たる目的は、新規な、ダマシン配線および半導体装置を提供することである。

この発明の他の目的は、ポンディングバッドにおけるディッシングに起因する 抵抗値の上昇や断線を防止できる、ダマシン配線およびそれを用いる半導体装置 を提供することである。

この発明に従ったダマシン配線は、次のものを備える:絶縁膜に形成された配線構およびこれに連通するパッド溝、パッド溝中において絶縁膜を部分的に除去しないことによって絶縁膜で形成されるかつパッド溝の実質的な開口面積を小さくする突起:および 配線溝およびパッド溝中に埋め込まれる導電膜。

このようなダマシン配線を半導体装置に用いた場合、その半導体装置は、次のものを備える:半導体基板;半導体基板上に形成される絶縁膜;絶縁膜上に形成されかつ半導体素子に通じる配線溝;絶縁膜上に形成されかつ配線溝に通じるパッド溝;パッド溝中において絶縁膜を部分的に除去しないことによって絶縁膜で形成されるかつパッド溝の実質的な開口面積を小さくする突起;および配線溝およびパッド溝中に埋め込まれる導電膜。

CMP法等によって導電膜を除去する際には、パッド溝を細分する突部が研磨材のストッパとして機能する。したがって、パッド溝中の導電膜が過剰に削り取られる、いわゆるディッシングは生じない。そのため、この発明によれば、ボンディングパッドにおけるディッシングに起因する抵抗値の上昇や断線を防止できる。

なお、突起はパッド滯中に埋め込まれた導電膜を分断しないように形成されて もよく、また導電膜を分断するように形成されてもよい。ただし、導電膜を分断 する場合には、分断された導電膜部分を互いに電気的に一体化する別の手段が必 要である。その別の手段は、絶縁膜に形成されたかつ導電膜と絶縁膜の下に配置 されている別の導電膜とを電気的に接続するコンタクトホールでよい。ただし、 コンタクトホールは、突起によってパッド溝内の導電膜を分断しない場合にも有 効である。

ある実施例では、突起はパッド溝中に適宜の間隔で分布される複数の島状突起

を含み、他の実施例では、突起は突条を含む。

この発明の上述の目的、その他の目的、特徴、および利点は、図面を参照して行う以下の実施例の詳細な説明から一層明らかとなろう。

図面の簡単な説明

- 図1は一般的なダマシン配線の方法を示す図解図であり:
- 図2はCMPの一般的な研磨特性を示すグラフである。
- 図3は従来技術を示す図解図であり:
- 図4は図3におけるⅣ-Ⅳ断面図であり:
- 図5はこの発明の一実施例を示す図解図であり:
- 図6は図5におけるVI-VI断面図であり;
- 図7は図5実施例の形成方法を示す図解図であり:
- 図8はこの発明の他の実施例を示す図解図であり;
- 図9はこの発明の他の実施例を示す図解図であり:
- 図10はこの発明の他の実施例を示す図解図であり;
- 図11は図10におけるXI-XI断面図であり:
- 図12はこの発明の他の実施例を示す図解図であり;そして
- 図13はこの発明の他の実施例を示す図解図である。

発明を実施するための最良の形態

図5および図6に示すこの実施例の半導体装置10は、たとえばシリコン(Si)等からなる半導体基板12を含む。ただし、半導体基板12の材料は他の任意のものであってよい。この半導体基板12上には、図示しないが、能動素子および/または受動素子を含む半導体素子が形成されている。

半導体装置 100 ダマシン配線部 11 は、半導体基板 12 上において、その半導体素子(図示せず)から延びる配線溝 16 、およびその配線溝 16 に連通するパッド溝 18 を含む。すなわち、半導体基板 12 上には、たとえば酸化シリコン($5iO_2$)等からなる絶縁膜 14 が一様の膜厚で形成され、絶縁膜 14 には、配線溝 16 およびこれに連通するパッド溝 18 が形成される。絶縁膜 14 の材料

は他の任意のものでよい。

なお、図5および図6では、図解および説明の簡単化のために、半導体基板12の表面に直接絶縁膜14が形成されたものとして図示されている。しかしながら、実際の半導体装置においては、周知のように、半導体基板12上に1層または複数層の半導体素子層を形成していて、各半導体素子層に必要に応じて配線層が形成されるものである。そして、上述の配線溝16は半導体素子(図示せず)とパッド溝18とを電気的に接続するもので、パッド溝18は、図示しないICフレームとの間でワイヤボンディングするためのボンディングパッドとして機能する。つまり、パッド溝18は各層の半導体素子を必要に応じてICフレームに引き出すための接続部である。

このようなダマシン配線部11では、従来では、配線溝16およびパッド溝18内に銅(Cu)、アルミニウム(Al)、テングステン(W)等のような導電膜を形成するだけであった。

しかしながら、この実施例においては、開口面積が相対的に大きいパッド溝18において、先に述べたディッシングを防止するために、以下の工夫が施されている。すなわち、パッド溝18内には、絶縁膜14が島状に残され、したがってパッド溝18は、その複数の島状突部20によって細分される。ただし、島状突起20はパッド溝18内の一部を他の一部から分断するものではなく、パッド溝18の島状突起20を除く部分は互いに連通している。つまり、この実施例のパッド溝18は、全体としては大きく開口されているが、島状突起20によって実質的な開口面積が小さくされている。具体的には、この実施例では、パッド溝18の一辺が50~200μm程度に設定され、突部20の間隔が5~20μm程度に設定される。

このように複数の島状突起20が形成されたパッド溝18内に、配線溝16内と同様に、上述の金属あるいは他の導電材料からなる導電膜22を形成する。したがって、半導体装置10に形成された半導体素子(図示せず)が、配線溝16中に埋め込まれた導電膜22を通して、パッド溝18すなわちパッド溝18内に埋め込まれた導電膜22に電気的に接続される。そのため、パッド溝18内に形成された導電膜22に接続ワイヤ(図示せず)をポンディングすることによっ

て、半導体素子が接続ワイヤすなわち I Cリードフレームと電気的に接続される。 以下には、図7に従って、上述のダマシン配線部11を有するこの実施例の半 導体装置10の具体的な製造方法を説明する。なお、図7においても、便宜上、 半導体基板12の表面に絶縁膜12が形成されているが、先に述べたように、半 導体装置10には適宜数の半導体素子層が形成されていて、図7は便宜上、1層 のみの配線構造のみを示すことに留意されたい。

図7 (a)に示すように半導体基板12上に熱酸化法等によって絶縁膜14を積層した後、図7 (b)に示すように絶縁膜14を、結果的に島状突起20が残るようにパターニングしたレジスト24でマスクして、エッチングすることによって、配線溝16およびパッド溝18を形成する。このときパッド溝18内には、複数の島状突起20が形成されている。続いて、レジスト24を除去した後、図7 (c)に示すように、配線溝16およびパッド溝18を含む半導体基板12上に、全面に亘って、たとえばCVD法や高温スパッタ法により、導電膜22を形成する。そして、図7 (d)に示すように、絶縁膜14上に形成された導電膜22をCMP法によって除去する。

CMP法では、定盤に張り付けられた研磨パッドに、基板ホルダに装着された 半導体基板12 (絶縁膜14および導電膜22を含む。)を押し当て、研磨パッドに研磨微粒子を含むスラリーを供給しながら、定盤および基板ホルダの双方を 回転する。そして、絶縁膜14上に形成された導電膜22が削り取られた時点で、 研磨を終了する。このとき、CMPでの絶縁膜14の研磨レートが導電膜22の 研磨レートよりも小さくなるように、研磨微粒子の種類(材料、粒度等)が選ばれる。発明者等の実験によれば、具体的には、(導電膜22の研磨レート) / (絶縁膜14の研磨レート) ≥20-10程度の研磨レートの比が望ましい。なぜなら、CMPでは、絶縁膜14上の導電膜22はできるだけ速く除去するの必要があるが、研磨による絶縁膜14自体の損傷をできるだけ防止するとともに、島状 突起20はパッド溝18内の導電膜22のオーバーポリッシュを防止するものであり、そのためには絶縁膜14の研磨に対する抵抗力を導電膜22のそれに比べて大きくする必要がある。

この実施例によれば、導電膜22の除去工程(図7(d))において、研磨レ

ートが小さい突部20(絶縁膜14)が研磨パッドによる導電膜22の研磨の進行を阻止するので、パッド溝18内の導電膜22が過剰に削り取られるのを防止できる。したがって、パッド溝18部分でのディッシングに起因する抵抗値の上昇や断線を防止できる。

つまり、図3および図4に示す従来技術では、パッド溝6の開口全面に研磨パッド(図示せず)が接触するので、開口面積の大きいパッド溝6の部分では、部分的にオーバーポリッシュが生じ、結果としてディッシングを生じている。これに対して、この実施例によれば、パッド溝18の全体の開口面積は大きいものの、開口が島状突起20によって細分され、島状突起20に挟まれた部分についてみれば、開口面積は小さくなる。そのため、オーバーポリッシュは生じず、結果的に、パッド溝18内の導電膜22の表面は、図6や図7(d)に示すように、平坦になる。

このように、この発明では、開口面積が大きいほど研磨レートが大きくなるという研磨特性を有するCMP法を用いるときに、パッド溝中に突起を形成することによって実質的な開口面積を小さくし、それによってディッシングを防止するようにしている。

なお、突部20は、パッド溝18を細分するものであればよく、その形状は、 図8に示すような直線であってもよく、あるいは図9に示すような螺旋であって もよい。

すなわち、図8に示す実施例では、矩形のパッド溝18の4辺のそれぞれの内線から内方に向かって延びるように複数の突起ないし突条20が形成される。ただし、この場合も、パッド溝18の他の部分は互いに連通する。この実施例でも、複数の突条20相互間および各辺から延びる突条相互間さらには、突条20とバッド溝18の内縁との間において、実質的な開口面積が減じられている。

図9の実施例では、パッド溝18内に、1本の突条20が螺旋状に形成される。 図9の実施例では、突条20が渦巻状に形成されるので、パッド溝18内が分断 されることはない。このように、螺旋状の突条20を形成することによって、突 条20の各部分間および突条20とパッド溝18の内縁間において、開口面積が 実質的に低減される。 また、必要であれば、図10~図13に示すように、パッド溝18の底部を構成する絶縁膜14に接続孔ないしコンタクトホール26を設け、導電膜22と図示しない下層の導電膜とをそのコンタクトホール26によって電気的に接続するようにしてもよい。

ここで、図10および図11を参照して、絶縁膜14にコンタクトホール26を形成する実施例について詳細に説明する。この実施例は、図11に示すように、絶縁膜14の下に別の層が形成されている半導体装置に適用される。すなわち、半導体基板12上には、別の絶縁膜28が形成され、その絶縁膜28上に別の導電膜30が形成される。そして、上述の絶縁膜14が別の導電膜30の上に形成される。パッド溝18の底面に、それぞれが絶縁膜14を貫通する複数のコンタクトホール26を形成する。パッド溝18中に金属膜ないし導電膜22を形成するとき、その金属ないし導電材料がコンタクトホール26中にも埋め込まれ、したがって、上層の導電膜22と下層の導電膜30とが互いに電気的に接続される。このように、パッド溝18にコンタクトホール26を形成して導電膜22および30を接続することによって、パッド溝18中に突起20を形成して導電は22および30を接続することによって、パッド溝18中に突起20を形成する場合に予想される不都合を解消することができる。

すなわち、この発明に従ってパッド溝18中に突起や突条を形成すると、パッド溝18の容積すなわちパッド溝18中の導電膜22の体積を減じることになる。パッド溝18中の導電膜22の体積が小さくなることによって、ボンディングパッドにおける電気抵抗が大きくなることが予想される。しかしながら、、図10 および図11実施例のように、導電膜22を導電膜30に接続するようにすれば、導電膜22の実効体積が増大されるので、電気抵抗の増大を可及的抑制することかできる。

図12に示す実施例は、図8実施例にコンタクトホール26を設けることによって、パッド溝18中の導電膜22を下層の導電膜と一体化するものである。

図13の実施例では、図9実施例とは異なり、突条20を閉鎖ループとして形成している。したがって、この実施例では、上述の各実施例とは異なり、パッド 溝18中の導電膜22が突条20によって分断されることになる。このような場合、上述のコンタクトホール26は特に有効である。すなわち、コンタクトホー

ル26を形成することによって、パッド溝18中の導電膜22が下層の導電膜30(図11)に接続されるので、その導電膜30を通してパッド溝18中の導電膜22の各分断部分が電気的に一体化される。つまり、図13実施例では、突条ないし突部20を閉鎖突条として形成しているが、導電膜22は接続孔26を通して下層の導電膜に接続されているので、突起ないし突条20によるパッド溝18内での断線の問題は生じない。

なお、この発明において、パッド溝の実質的開口面積を減じるための突起ない し突条は、パッド溝内に、複数設けられてもよく、1つの突起ないし突条のみが 用いられてもよい。

この発明が詳細に説明され図示されたが、それは単なる図解および一例として用いたものであり、限定であると解されるべきではないことは明らかであり、この発明の精神および範囲は添付されたクレームの文言によってのみ限定される。

請求の範囲

1. 次のものを備えるダマシン配線:

絶縁膜に形成された配線溝およびこれに連通するパッド溝;

前記パッド溝中において前記絶縁膜を部分的に除去しないことによって前記絶縁膜で形成されるかつ前記パッド溝の実質的な開口面積を小さくする突起:および

前記配線溝および前記パッド溝中に埋め込まれる導電膜。

- 2. クレーム1に従属するダマシン配線であって、前記突起は前記パッド溝中に埋め込まれた前記導電膜を分断しないように形成される。
- 3. クレーム2に従属するダマシン配線であって、前記突起は前記パッド溝中に適宜の間隔で分布される複数の島状突起を含む。
 - 4. クレーム2に従属するダマシン配線であって、前記突起は突条を含む。
- 5. クレーム1に従属するダマシン配線であって、前記突起は前記パッド溝中に埋め込まれた前記導電膜を分断するように形成される。
- 6. クレーム5に従属するダマシン配線であって、前記突起は前記パッド溝内において一部を囲む閉鎖突条を含む。
- 7. クレーム1ないし6のいずれかに従属するダマシン配線であって、さらに前記パッド溝中に形成されるかつ前記導電膜と前記絶縁膜の下に配置されている別の導電膜とを電気的に接続するコンタクトホールを備える。
 - 8. 次のものを備える半導体装置:

半導体基板:

前記半導体基板上に形成される絶縁膜;

前記絶縁膜上に形成されかつ半導体素子に通じる配線溝;

前記絶縁膜上に形成されかつ前記配線溝に通じるパッド溝;

前記パッド溝中において前記絶縁膜を部分的に除去しないことによって前記絶 縁膜で形成されるかつ前記パッド溝の実質的な開口面積を小さくする突起;および

前記配線溝および前記パッド溝中に埋め込まれる導電膜。

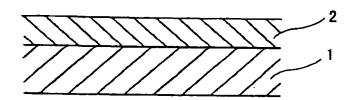
9. クレーム8に従属する半導体装置であって、前記突起は前記パッド溝中に

埋め込まれた前記導電膜を分断しないように形成される。

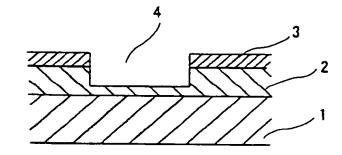
- 10. クレーム9に従属する半導体装置であって、前記突起は前記パッド溝中に適宜の間隔で分布される複数の島状突起を含む。
 - 11. クレーム9に従属する半導体装置であって、前記突起は突条を含む。
- 12. クレーム8に従属する半導体装置であって、前記突起は前記パッド溝中に埋め込まれた前記導電膜を分断するようにに形成される。
- 13. クレーム12に従属する半導体装置であって、前記突起は前記パッド構内において一部を囲む閉鎖突条を含む。
- 14. クレーム8ないし13のいずれかに従属する半導体装置であって、さらに前記絶縁膜の下に形成される別の導電膜;および前記パッド溝中において前記絶縁膜に形成されるかつ前記導電膜と前記別の導電膜とを電気的に接続するコンタクトホールを備える。

図 1

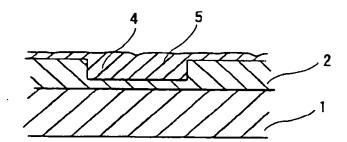
(a)



(b)



(c)



(d)

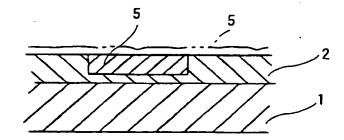


図2

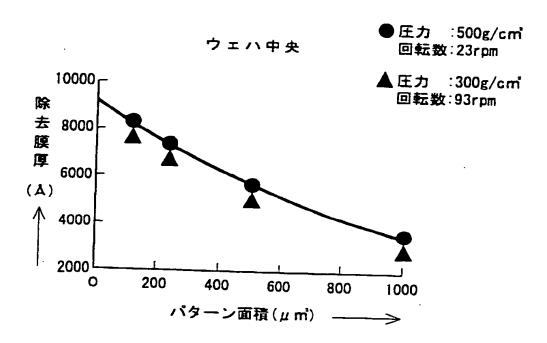
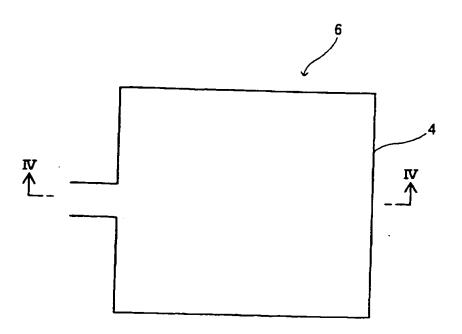
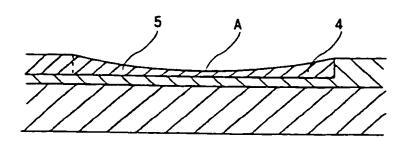


図3



30

2 4



2 5

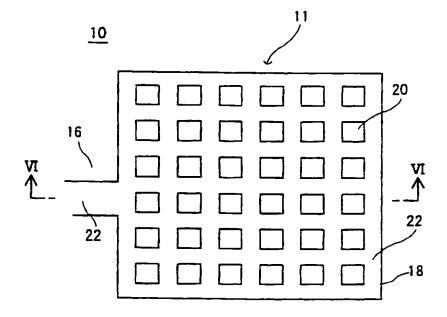
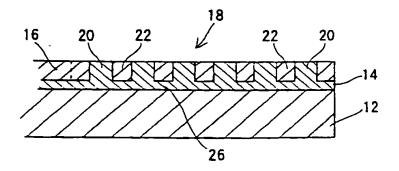
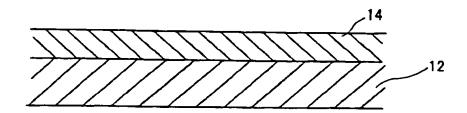


図 6

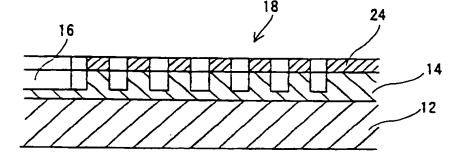


図フ

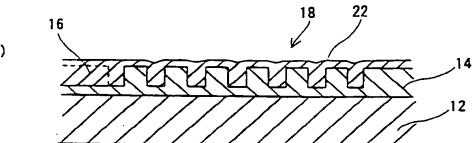
(a)



(b)



(c)



(d)

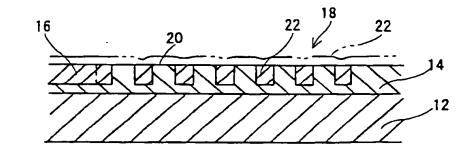
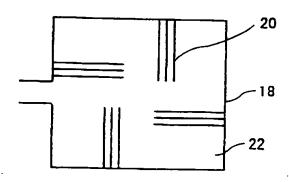


図 8



2 9

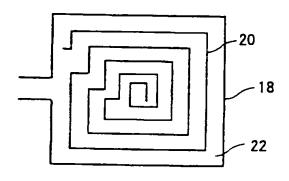
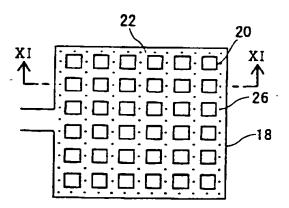


図10



WO 99/38204

図11



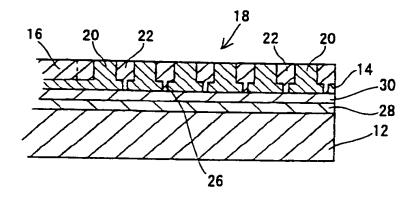


図12

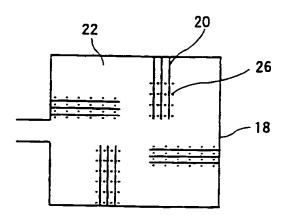
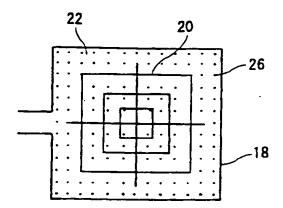


図13



特許協力条約に基づく

願

I**A** II

書

国際出版番号			
医一种 出 願 日			
(受付印)			
出版人又は代理人の書類記号 (お望する場合、最大 1 2字)	PCT-0040		

出願人は、この国際出願が特許協力条	(受付印)	
約に従って処理されることを脚水する。	<u></u>	
	出層人又は代理人の書類記号 (希望する場合、最大 1 2 字)	PCT-0040
第1個 発明の名称		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ダマシン配線および半導体装置		
第 章 棚 巴爾人	· :	
氏名(名称)及びあて名:(姓・名の斯に記載:佐人は公式の完全な名称を記載	; あて名は郵便番号及び国名も記載)	この棚に記載した者は、
ローム株式会社 Rohm Co., Ltd.	•	単二 発明者でもある。 電話番号:
〒615-0045 日本国京都府京都市右京区西院流	構崎町21	
21, Saiin Mizosaki-cho, Ukyo-ku, Kyoto-shi, KYC	OTO 615-0045 Japan	
	•	ファクシミリ番号:
		加入電信番号:
回頭(四名): 日本国 Japan	(E新 (图名): 日本国 Japan	
この欄に記載した者は、次の 揖定国についての出顧人である: すべての揖定国 x 米国を開	はくすべての指定国 米国のみ	追記機に記載した指定国
第111欄 その他の出願人文は発明者		
氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に記載:佐人は公式の完全な名称を記載:	あて名は郵便番号及び国名も記載)	この機に記載した者は 次に該当する:
		人に終まする :
山本 浩史 YAMAMOTO Koji	Hr Arte Mare Co a	出願人のみである。
〒615-0045 日本国京都府京都市右京区西院港	髯崎町21	▼ 出願人及び発明者である。
ローム株式会社内		X marked here to be
c/o Rohm Co., Ltd.	TO 615 0045 James	発明者のみである。
21, Saiin Mizosaki-cho, Ukyo-ku, Kyoto-shi, KYO	10 613-0043 Japan	(ここに V 印を付したとき は、以下に起入しないこと)
	т	
^{国語(図名)} : 日本国 Japan	^{住所(図名)} :日本国 Japan	
この欄に記載した者は、次の	くすべての指定国 🗶 米国のみ	追起機に記載した指定国
X その他の出願人又は発明者が収集に記載されている。		
第12個 代理人又は共通の代数省、通知の	りあて名 .	
次に記載された者は、国際機関において出額人のために行動する:	x 代與人	共通の代表者
氏名(名称)及びあて名:(姓・名の廟に記載:佐人は公式の完全な名称を記載:	あて名は郵便番号及び国名も記載)	戏話番号:
9018 弁理士 山田 義人 YAMADA Yos		06-6229-0531
〒541-0044 日本国大阪府大阪市中央区伏見町		ファクシミリ番号:
The Tanabe Building, 6-6, Fushimimachi 2-chome,		
Chuo-ku, Osaka-shi, OSAKA 541-0044 Japan		06-6229-9675
		加入或信告号:
通知のためのあて名:代理人又は共通の代表者が遺任されておらず、上記枠	内に特に通知が送付されるあて名を記載して	いる場合は、レ印を行す

2 2	

	哲				
この経典を使用しないときは、この用紙を顧客に含めないこと。					
氏名(名称)及びあて名:(姓・名の斯に記載;佐人は公式の完全な名称を記載	;あて名は郵便番号及び国名も	•	この個に記載した者は、 次に該当する:		
熊本 信久 KUMAMOTO Nobuhisa 〒615-0045 日本国京都府京都市右京区西院		出版人のみである。			
ローム株式会社内	丹岬町叫」2 1	ĺ	X 出願人及び発明者である。		
c/o Rohm Co., Ltd. 21, Saiin Mizosaki-cho, Ukyo-ku, Kyoto-shi, KYO	OTO 615-0045 Japan		無明者のみである。 (ここにレ印を付したとき は、以下に起入しないこと)		
			は、以下に記入しないこと)		
(国語 (四名): 日本国 Japan この側に記載した者は、次の	住所(图名): 日之	►国 Japan			
		米国のみ	追記機に記載した指定国 この機に記載した者は、		
松本 宗之 MATSUMOTO Muneyu			大に該当する:		
〒615-0045 日本国京都府京都市右京区西院			出願人のみである。		
ローム株式会社内 c/o Rohm Co., Ltd.			X 出顧人及び発明者である。		
21, Saiin Mizosaki-cho, Ukyo-ku, Kyoto-shi, KYC	TO 615-0045 Japan		発明者のみである。 <i>(ここにレ用を付したとき</i> は、以下に記入しないこと)		
(日本): 日本国 Japan	住所 (国名) : 日之	国 Japan			
この棚に記載した者は、次の	なくすべての指定国 👿	米国のみ	追記機に記載した指定国		
氏名(名称)及びあて名:(姓・名の動に記録:佐人は公式の完全な名称を記載			の欄に記載した者は、		
		ð	大に該当する:		
			出願人のみである。		
					
			出願人及び発明者である。		
		(出願人及び発明者である。 ・		
ចេ <i>ត (មេន)</i> :	住所 ((((((((((((((. [発明者のみである。		
この欄に記載した者は、次の すべての投票値 すべての	住所 (図名):	米国のみ	発明者のみである。		
この欄に記載した者は、次の	くすべての指定国	(4年) 二	発明者のみである。 (ここにレ印を付したとき は、以下に起入しないこと)		
この欄に記載した者は、次の	くすべての指定国	(4年) 二	発明者のみである。 (ここにレ印を付したとき は、以下に記入しないこと) 追記機に記載した指定国 の機に記載した者は、		
この欄に記載した者は、次の	くすべての指定国	(4年) 二	発明者のみである。 (ここにレ印を付したとき は、以下に記入しないこと) 追記機に記載した指定国 の機に記載した者は、 (に該当する:		
この欄に記載した者は、次の	くすべての指定国	(4年) 二	発明者のみである。 (ここにレ印を付したとき は、以下に起入しないこと) 追起欄に記載した指定国 の顔に記載した者は、 (に該当する:		
この欄に記載した者は、次の	くすべての指定国	(4年) 二	発明者のみである。 (ここにレロを付したとき は、以下に記入しないこと) 追記間に記載した指定国 の傾に記載した者は、 に該当する: 出願人のみである。 出願人のみである。		
この欄に記載した者は、次の 辯定限についての出類人である: すべての指定国 米頃を新 氏名 (名称) 及びあて名: (姓・名の前に記載: 佐人は公式の完全な名称を記載: は頃 (四名): この欄に記載した者は、次の	(・すべての指定国 あて名は郵便番号及び図名も和 住所 (図名):	(4年) 二	発明者のみである。 (ここにレロを付したとき は、以下に記入しないこと) 追記間に記載した指定国 の傾に記載した者は、 に該当する: 出願人のみである。 出願人のみである。		

跳 人 48	国の指定	
規則 4.9(a)	の規定に基づき次の指定を行う(は当するロにレ印を付すこと:	少なくとも1つのロにレ印をはナート)
广广小皮中华普		t t t t
IMAR	ARIPOWER CELT-+ Change	M ガンピア Gambia、K E ケニア Kenya、L S レント Lesotho、
	TOT VV 7794 Marati, S 13 X-99 Sudan, S 2	スワジランド Seaziland、モエク、ウサンダ Ununda、 マススス さいパー
Í	Zimbdove, 及びパブレブロドコルと行計個力決約の類別国である	題の日
EA	ユーラシア特件: AM アルメニア Armeni	a. A Z アゼルバイジャン Azerbaijan, BY ベラルーシ Belarus,
	TO THE ANTIBITION. IN A DIVINEY AND	hstan, M D モルドヴァ Republic of Woldows, R U ロシア Russian レクメニスタン Turkmenistan。 及びユーランア特許条約と特許協力条約の締約囚
	である他の国	レックーベック Turkmenistan。 及びユーフシア特許染約と特許協力条約の締約国
XEP	ヨ ― ロ ッノベキ学館: 本 エーストリノ Aust	TIA IS FOR NAVES HAIGHING COLOR HAID I AND AND THE PARTY OF THE PARTY
	**************************************	Grown DE KAY Comers DE State of the State of
i	A To Spain, L L TYPY Finland, F R	フランス France, G B 英国 United Kingdom, G R サリン・ freeren
	> 4 Metherlands, P T HA MA Portugal. S E AS	A デン Seeden ルジョ ロック特許をおり、特許協力を約の解析例である他の例
		ina Faso, BJベナン Benin, CF 中央アフリカ Central African
	Republic, C C コンコー Congo, C I コートジボア・	ール Coted Ivoire. C M カメルーン Camernoo C A サポシ Caban
	C IN *=/ Guinea, M.L. vy Mali, M.R. &-	リタニア Mauritania, NT 巨 ニジェール Niger, S IV セネガル Scnegal, リカ知的所有権機構のメンバー国と特許協力条約の締約国である他の国 <i>(他の層類</i>
	の保護又は取扱いを求める場合には点線上に記載する)	・ スル町の19 福成語のメンハー国で付計協力条約の類約国である他の国(<u>他の雇</u> 棄
1921 人口编辑	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	······
	TNX=T Albania	L T Jhr=r Lithuania
	アルメニア Armenia	L U ルクセンブルグ Luxembourg
	オーストリア Austria	□ L V ラトヴィア Latvia
	オーストラリア Austrulia アゼルバイジャン Azerbuijan	■ M D モルドヴァ Republic of Moldova
· —		□ MG マダガスカル Medagascar
	ボスニア・ヘルツェゴヴィナ Hosnia and Herzegovina	■ M K マケドニア旧ユーゴースラヴィア共和国 The former Yugoslav Republic of Macedonia
	バルバドス Barbados	
		■ MN モンゴル Mongolia
	ブルガリア Bulgaria	☐ MW マラウイ Malavi
	ブラジル Brazil	M × メキシコ Mexico
	ベラルーン Belarus	□ NO ノールウェー Norway
	カナダ Canada	□ N Z =ュー・ジーランド Now Zealand
	and l。 I スイス及びリヒテンシュタイン Switzerland and Liechtenstein	PL ポーランド Poland
		P T ポルトガル Portugal
	中国 China	RON-v=7 Romania
	キューバ Cuba	R U ロシア Russian Federation
	チェッコ Czech Republic	SD スーダン Sudan
	ドイツ Germany	S E スウェーデン Sweden
	デンマーク Denmark	S G シンガポール Singapore
	エストニア Estonia	S I スロヴェニア Slovenia
	スペイン Spuin	S K スコヴァキア Slovakia
	フィンランド Finland 英国 United Kingdom	□ S L シエラ・レオーネ Sierra Loone
		T J タジキスタン Tajikistan
	グルジア Georgia	TMトルクメニスタン Turkmenistan
	ガーナ Ghana ガンビア Gembia	TR トルコ Turkey
		T T トリニダッド・トバゴ Trinidad and Tobago
	ギニア・ビサオ Guinea-Bissau クロアチア Croatia	☐ UA ウクライナ Ukraine
l		UG ウガンダ Uganda
	ハンガリー hungary インドネシア Indonesia -	又 U S 米国 United States of America
	イスラエル Israel	U Z ウズベキスタン Uzbekistan
	アイスランド Iceland	□ V N ヴィエトナム Viet Nam
	日本 Japan	□ Y U ユーゴースラヴィア Yugoslavia
	ケニア Kenya	□ Z W ジンパブエ Zimbabve
M K R	キルギス Kyrgyzstun	以下の口は、この様式の施行後に特許協力条約の締約国となった国を指定(区
	韓国 Republic of Korea	内特許のために)するためのものである
	カザフスタン Kazakhstan	
	セント・ルシア Saint Lucia	
	スリ・ランカ Sri Lanka リベリア Liberia	
	レント Lesotho	

確認の相定の宣言:出願人は、上記の指定に加えて、規則 4.9(b)の規定に基づき、特許協力条約の下で認められる他の全ての国の指定を行う。ただし、この宣言から除く旨の表示を追記機にした国は、指定から除かれる。出願人は、これらの追加される指定が確認を条件としていること、並びに優先日から15月が経過する前にその確認がなされない相定は、この期間の経過時に、出願人によって取り下げられたものとみなされることを宣言する。 (信定の確認は、程定を特定する通過の提出と信定手数科及び確認手数料の動材からなる。この確認は、優先日から15月以内に受理管所へ提出しなければならない。)

第VI欄 個先格	हिल्ला भार	他の優先権の主張(先の出額)が	追起間に記載している	
先の出願日	先の出顧番号		先の出版	
(#. Jl. ¶)		四四四百 : 四名	広域出版 : 本広城官庁名	国際出籍 : 受理官庁名
23. 01. 98	平成10年特許願 第011354号	日本国 Japan		
(2)				
(3)				
上記 () の番号の先の も <i>のに限る</i>) のうち、次 事務局へ送付することを	 出類 <i>(ただし、本国際出動が型』</i> の() の番号のものについてに 、受理官庁(日本国特許庁の長)	川される受理官庁に対して提出され は、出願書類の認証謄本を作成し図 (す) に対して請求している。 :	.た 際	
* 注の出願が、ARIPOU ればならない(規則4、1	特許川順である場合には、その) O (b) (ii) 。 迫記欄を参照。	光の出版を行った工業所有権の保護	のためのパリ条約局型国の少なく	とも1ヶ国を追記機に表示しなけ
2FS VII 相侧	金機関	···		
國際調查機関(「SA)の遊択	死の調査結果の系	1月韵火:当溪湖	金の原金(先の調査が
1		国際調査機関によって既に実施又 11版11 (日、月、年)	<i>(は請求されている場合)</i> 出額番号	([4名(又は広城官庁)
ISA/	j į-			
33. VIII 相關 电电台 中国	: 日本頃ひ 巻は春			
この国際出額の用紙の枚数は次			類が舐付されている。	
MG 25 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		¬		第Ⅵ個の()の番号を記載する)
明細書(配列表を除く)・・	8 🕸 📙	── - 納付する手数件に担当する特許 - 印紙を貼付した書面		
油水の範囲 ・・・・・・	·· 2 🕸	国際事務局の口座への扱込みを	_	(翻訳に使用した言語名を記載す
契約書 ・・・・・・・	· · 1 # 2.	 一 証明する書面 別個の記名押印された委任状 	₩ 5) :	は他の生物材料に関する書面
Estilia · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · 6 & 3.	□ □ 包括委任状の写し	8. コタクレオチドソは	アミノ酸剤が以
明細書の配列表・・・・・	· · · · · · · · · · · · · · · ·	□ □ 記名押印(署名)の説明書	9. フレキシブルディ 9. マの他 (<i>は数名を</i>)	(スク)
	21	_		
会 計 要約事とともに提示する図面:	図 5 本世	印際出額の使用含語名: ロラ	本市岳	
3g IX HM 标口表	の記名押印			
各人の既名(名称)を記載し、	その次に押印する。			
	山田 義人	印		
	·			
1. 国際出願として提出された	書類の実際の受理のIT	- 受现的产能入機		2. 氢咖
3. 国際出願として提出された	事類を補完する事類文は図面であ	って		受理された
	ものの実際の受理の日(訂正日)			不足図曲がある
4. 特許協力条約第1 1条(2)に基づく必要な細定の期間内の受理の日				
5. 出版人により特定された	ISA/JP	6.	広いにつき、国際調査機関に	\dashv
国際調養機関		国際事務局電入相	を付していない 201	
				
記録原本の受理の日 様式PCT/RO/101 ()	战務川祇) (1993年7月)			

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/JP99/00225

- CI 46	ATTENDED OF STREET		
Int	SIFICATION OF SUBJECT MATTER .C1 H01L21/3205		
	to International Patent Classification (IPC) or to both	national classification and IPC	
		11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Int	documentation searched (classification system followers: C1 ⁶ H01L21/3205		
Jits	tion searched other than minimum documentation to t uyo Shinan Koho 1926-1999 i Jitsuyo Shinan Koho 1971-1999	he extent that such documents are include Toroku Jitsuyo Shinan Koh	d in the fields searched 1994–1999
Electronic	data base consulted during the international search (na	me of data base and, where practicable, s	earch terms used)
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where a		Relevant to claim No.
х	JP, 6-318590, A (NEC Corp.) 15 November, 1994 (15. 11. 9	, 94) (Family: none)	1-14
Furthe	r documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	
Special	categories of cited documents:	"T" later document published after the intern	ational filing date or priority
"A" docume consider "E" earlier of "L" docume cited to special of docume means "P" docume the prior	ant defining the general state of the art which is not ted to be of particular relevance locument but published on or after the international filing date in twhich may throw doubts on priority claim(s) or which is establish the publication date of another citation or other reason (as specified) intreferring to an oral disclosure, use, exhibition or other introduced prior to the international filing date but later than rity date claimed	date and not in conflict with the applicate the principle or theory underlying the in "X" document of particular relevance; the classification of considered novel or cannot be considered when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the classification of considered to involve an inventive step we combined with one or more other such displayed being obvious to a person skilled in the additional search of the same patent far	ion but cited to understand vention imed invention cannot be it to involve an inventive step simed invention cannot be when the document is occuments, such combination int nily
	ril, 1999 (02. 04. 99)	13 April, 1999 (13.	
	nese Patent Office	Authorized officer	
Facsimile No) .	Telephone No.	



PCT

E P



国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 PCT-0040	今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220) 及び下記5を参照すること。						
国際出願番号 PCT/JP99/00225	国際出願日 (日.月.年) 22.01.99	優先日 (日.月.年) 23.01.98					
出願人 (氏名又は名称) ローム株式							
国際調査機関が作成したこの国際調 この写しは国際事務局にも送付され	査報告を法施行規則第41条(PCT18彡 る。	条) の規定に従い出願人に送付する。					
この国際調査報告は、全部で 2	ページである。						
この調査報告に引用された先行:	技術文献の写しも添付されている。						
□この国際調査機関に提出さ	くほか、この国際出願がされたものに基っ れた国際出願の翻訳文に基づき国際調査	を行った。					
b. この国際出願は、ヌクレオチ この国際出願に含まれる甚	ド又はアミノ酸配列を含んでおり、次のi f面による配列表	配列表に基づき国際調査を行った。					
□ この国際出願と共に提出さ	れたフレキシブルディスクによる配列表	€					
<u> </u>	機関に提出された書面による配列表	·					
□ 出願後に、この国際調査機	複関に提出されたフレキシブルディスクに	よる配列表					
出願後に提出した書面によりの提出があった。	こる配列表が出願時における国際出願の関	引示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述					
□ 帯面による配列表に記載し 事の提出があった。	,た配列とフレキシブルディスクによる 面	已列表に記録した配列が同一である旨の陳述					
2. 請求の範囲の一部の調査	ができない(第1欄参照)。						
3. 党明の単一性が欠如して	いる(第日欄参照)。						
4. 発明の名称は 🗓 出	願人が提出したものを承認する。						
	に示すように国際調査機関が作成した。						
· .		<u> </u>					
1 2	願人が提出したものを承認する。	·					
	Ⅲ欄に示されているように、法施行規則 際調査機関が作成した。出願人は、この 国際調査機関に意見を提出することがで	第47条 (PCT規則38.2(b)) の規定により 国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこ きる。					
6. 要約事とともに公表される図は 第5 図とする。 X '出	:、 願人が示したとおりである。	□ なし					
_ t	願人は図を示さなかった。						
*	図は発明の特徴を一層よく表している。						

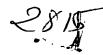
	· W	
国際認	査	報告

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))		
Int. Cl* H01L21/3205		
B. 調査を行った分野	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))		
Int. Cl° H 0 1 L 2 1 / 3 2 0 5		
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの		
日本国実用新案公報 1926-1999年日本国登録実用新案公報 1994-1999年		
日本国公開実用新案公報 1971-1999年	·	
国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、	調査に使用した用語)	
		٠
	•	
C. 関連すると認められる文献		関連する
引用文献の カテゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	きは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
X JP, 6-318590, A (日本電15.11月.1994 (15.11	i気株式会社), 94)(ファミリーなし)	1-1 4
	·	
	── パテントファミリーに関する別	
□ C欄の続きにも文献が列挙されている。		
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表	された文献であって
もの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日	て出願と矛盾するものではなく 論の理解のために引用するもの	
以後に公表されたもの	「X」特に関連のある文献であって、 の新規性又は進歩性がないと考	
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する	「Y」特に関連のある文献であって、	当該文献と他の1以
文献 (理由を付す)	上の文献との、当業者にとって	自明である組合せに
「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	よって進歩性がないと考えられ 「&」同一パテントファミリー文献	≎ € <i>0</i> /
国際調査を完了した日 02.04.99	国際調査報告の発送日 13.04	.99
国際調査機関の名称及びあて先	特許庁審査官(権限のある職員)	3 4L 9054
日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915	瀧内 健夫	y
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101	内線 6761





PCT



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference PCT-0040	FOR FURTHER ACTIO		tionofTransmittalofInternational Preliminary n Report (Form PCT/IPEA/416)
International application No. PCT/JP99/00225 International filing date (day/month/year) Priority date (day/month/year) 22 January 1999 (22.01.99) 23 January 1998 (23.01.99)			
International Patent Classification (IPC) or H01L 21/3205	national classification and IP	c	
Applicant	ROHM CO.,	LTD.	
and is transmitted to the applicant a 2. This REPORT consists of a total of	ccording to Article 36. 4 sheets, incl	uding this cover s	national Preliminary Examining Authority heet. iption, claims and/or drawings which have
been amended and are the ba Rule 70.16 and Section 607 These annexes consist of a to	sis for this report and/or she of the Administrative Instruc	ets containing rections under the PC	ctifications made before this Authority (see CT).
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			RECEIVED
3. This report contains indications rela	iting to the following items:		DEC 0 7 2000
Basis of the report			TECHNOLOGY CENTER 2800
II Priority			TEGINOLOGI. GEVANIA
III Non-establishment	of opinion with regard to nov	elty, inventive ste	ep and industrial applicability
IV Lack of unity of inv	ention		
v Reasoned statement citations and explan	under Article 35(2) with reg ations supporting such stater	ard to novelty, inv nent	ventive step or industrial applicability;
VI Certain documents of	cited		
VII Certain defects in th	e international application		
VIII Certain observations	s on the international applica	tion	
		<u> </u>	
Date of submission of the demand	Date	of completion of	f this report
14 July 1999 (14.07.	99)	07 <i>A</i>	April 2000 (07.04.2000)
Name and mailing address of the IPEA/JP	Aut	norized officer	
Facsimile No.	Tele	phone No.	



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

ational application No.

PCT/JP99/00225

I.	Basis	of the re	report	·
1.	With	regard to	to the elements of the international application:*	
	\boxtimes	the inte	ernational application as originally filed	
		the des	scription:	
		pages		, as originally filed
		pages	,,	_
		pages	, filed with the letter of	
		the clai	ims.	
	ш	pages		_, as originally filed
		pages	, as amended (together with any stater	, as originally flicu
		pages	. , , , , ,	
		pages	, filed with the letter of	
		the draw	awings:	
	ш			oo originally filed
		pages pages		
		pages	, filed with the letter of	ned with the demand
	$\overline{}$			
	LJ t		ence listing part of the description:	
		pages		
		pages	, t	
		pages	, filed with the letter of	
2.	the ir	nternation	to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the small application was filed, unless otherwise indicated under this item. In this were available or furnished to this Authority in the following language	he language in which which is:
	\square	the lang	aguage of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).	
	Щ	the lang	guage of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).	
		the lan or 55.3	aguage of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (0).	inder Rule 55.2 and/
3.	With	regard minary ex	to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application examination was carried out on the basis of the sequence listing:	on, the international
		contain	ned in the international application in written form.	
		filed to	ogether with the international application in computer readable form.	
		furnish	ned subsequently to this Authority in written form.	
	\sqcup	furnish	ned subsequently to this Authority in computer readable form.	
			tatement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the stional application as filed has been furnished.	e disclosure in the
			atement that the information recorded in computer readable form is identical to the written urnished.	sequence listing has
4.		The am	nendments have resulted in the cancellation of:	
			the description, pages	
			the claims, Nos.	
			the drawings, sheets/fig	
5.		This rep	port has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have be the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**	een considered to go
	Replai in thi, and 7(s report	sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Artic as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amen	le 14 are referred to dments (Rule 70.16
		•	ent sheet containing such amendments must be referred to under item I and annexed to this repo	- _{t.}
		-		

INTERNATIONAL PRELENARY EXAMINATION REPORT

V.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
	citations and explanations supporting such statement

1.	Statement			
	Novelty (N)	Claims		YES
:		Claims	1-14	NO
	Inventive step (IS)	Claims		YES
		Claims	1-14	NO
	Industrial applicability (IA)	Claims	1-14	YES
		Claims		NO

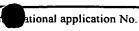
2. Citations and explanations

Claims 1 to 14

Document 1 (JP, 9-148329, A (Canon Inc.), June 6, 1997 (06.06.97), full text; Fig. 1 to 13) discloses a bonding pad for preventing dishing in polishing wherein a square, a strip-shaped or a lattice-shaped insulation film is deposited within the pad grooves as well as the feature of the bonding pad being electrically connected to the lower section wiring by means of a contact hole. Therefore, the invention described in Claims 1 to 14 forms a part of the bonding pad disclosed in Document 1 and, thus, lacks novelty.

Claims 1 to 4 and 8 to 11

Document 2 (JP, 6-318590, A (NEC Corp.), November 15, 1994 (15.11.94), full text; Fig. 1 to 3) discloses a bonding pad for preventing excess polishing, wherein a column-shaped or a slit-shaped insulation film is deposited within the pad grooves. Therefore, the invention described in Claims 1 to 4 and 8 to 11 forms a part of the bonding pad disclosed in Document 2 and, thus, lacks novelty.



PCT/JP99/00225 VI. Certain documents cited 1. Certain published documents (Rule 70.10) Application No. Publication date Priority date (valid claim) Filing date Patent No. (day/month/year) (day/month/year) (day/month/year) JP, 10-064938, A 06 March 1998 (06.03.1998) 21 September 1996 (21.09.1996) [EX] JP, 10-229085, A 25 August 1997 (25.08.1997) [EX] 2. Non-written disclosures (Rule 70.9) Date of written disclosure Kind of non-written disclosure Date of non-written disclosure referring to non-written disclosure

(day/month/year)

(day/month/year)

特許協力条約

PCT

国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の書類記号 PCT-0040	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。			
国際出願番号 PCT/JP99/00225	国際出願日 (日.月.年). 22.01.99	優先日 (日.月.年) 23.01.98		
国際特許分類 (IPC) Int.Cl ⁷ H01L21/3	2 0 5			
出願人 (氏名又は名称) ローム株式会社				
	国際予備審査報告を法施行規則第57条(PC	_		
2. この国際予備審査報告は、この表制	我を含めて全部で4 ペーシ	^え からなる。		
査機関に対してした訂正を含む	対属書類、つまり補正されて、この報告の基 専明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付	を礎とされた及び/又はこの国際予備審 けされている。		
(PCT規則70.16及びPCT この附属番類は、全部で				
3. この国際予備審査報告は、次の内容	. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。			
I x 国際予備審査報告の基礎				
Ⅱ				
Ⅲ	Ⅲ			
IV 免明の単一性の欠如				
	る新規性、進歩性又は産業上の利用可能性	についての見解、それを裏付けるため		
の文献及び説明 VI x ある種の引用文献				
VII 国際出願の不備				
VII 国際出願に対する意見				
		·		

国際予備審査の請求審を受理した日 14.07.99	国際予備審査報告を作成した日 07.04.00
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区改が関三丁目4番3号	特許庁審査官(権限のある職員) 4L 9733 北島 健次 (印) 電話番号 03-3581-1101 内線 3496

国際予備審査報告

国際出願番号 PCT/JP99/00225

I	. 1	国際予備審查報	最告の基礎				
1	1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。 (法第6条 (PCT14条) の規定に基づく命令に 応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。 PCT規則70.16,70.17)						
	x	出願時の国際	際出願書類				
		明細書 明細書	第 第 第		ページ、 ページ、 ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と	
		請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲	第 第 第 第		項、 項、 項、 項、	出願時に提出されたもの PCT19条の規定に基 国際予備審査の請求書と	づき補正されたもの
		図面 図面	第 第 第 第		ページ/図、 ページ/図、 ページ/図、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と	
		明細書の配列	表の部分 第 表の部分 第 表の部分 第		ページ、 ページ、 ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と 	
2.	_	上記の書類は、	(の言語は、下記) 下記の言語であっために提出され	ర	語であ	- •	
	[国際予備		されたPCT舞	見則55.2また	は55.3にいう翻訳文の言語	
3.	: [–	:、ヌクレオチド] 出願に含まれる書			おり、次の配列表に基づき	国際予備審査報告を行った。
			出願と共に提出さ この国際予備審			による配列表 出された書面による配列表	£
	[出願後に、	この国際予備審	査(または調査	生)機関に提	出されたフレキシブルディ	
		書の提出が	があった 5 配列表に記載し				た配列が同一である旨の陳述
4.		明細書	記の書類が削除る 第 第 図面の第	=	^	Ž∕⊠	
5.		ー この国際予備 れるので、そ	審査報告は、補ま	いったものとし	うに、補正な て作成した 。	・ 一 が出願時における開示の範値 (PCT規則70.2(c) この	囲を越えてされたものと認めら の補正を含む差し替え用紙は上

国際予備審查報告

国際出願番号 PCT/JP99/00225

V.	新規性、進歩性又は産業上の利用可 文献及び説明	能性についての法第12条(PCT3 	: 5条(2)) に定める見解、 	それを裏付ける
1.	見解			
	新規性(N)	請求の範囲 請求の範囲	1-14	
	進歩性(IS)	請求の範囲 請求の範囲	1-14	
	産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲 請求の範囲	1-14	

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

請求の範囲1-14

文献1: JP, 9-148329, A (キヤノン株式会社) 6.6月.1997 (06.06.97) 全文, 図1-13

上文, 図1-13 には、研磨の際のディッシングを防止するために、パッド溝中に正方形、ストライプ状又は格子状の絶縁膜を残存させたボンディングパッドが記載されており、さらに、ボンディングパッドがコンタクトホールを介して下部の配線に電気的に接続されることが記載されている。したがって、請求項1-14に記載された発明は、上記文献1に記載されたボンディングパッドの一部をなすものであり、新規性を有しない。

請求の範囲1-4,8-11

文献 2: JP, 6-318590, A (日本電気株式会社) 15.11.1994(15.11.94) 全文, 図1-3

には、過剰な研磨を防止するために、パッド溝中に柱状又はスリット状の絶縁膜を 残存させたボンディングパッドが記載されている。したがって、請求項1-4及び8 -11に記載された発明は、上記文献2に記載されたボンディングパッドの一部をな すものであり、新規性を有しない。

国際予備審查報告

国際出願番号 PCT/JP99/00225

VI. ある種の引用文献	
--------------	--

1. ある種の公表された文書 (PCT規則70.10)

出願番号 ————————————————————————————————————	公知日 (日.月.年)	出顧日 (日.月.年)	優先日(有効な優先権の主張) (日、月、年)
JP, 10-064938, A	06. 03. 98	21. 09. 96	
JP, 10-229085, A	25. 08. 98	14. 02. 97	,

2. 書面による開示以外の開示 (PCT規則70.9)

書面による開示以外の開示の種類	魯面による開示以外の開示の日付	書面による開示以外の開示に言及している
	(日.月.年)	書面の日付(日、月、年)

PATENT COOPERATION TREAM

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT	То:	
NOTIFICATION OF ELECTION (PCT Rule 61.2)	Assistant Commissioner for Patents United States Patent and Trademark Office Box PCT Washington, D.C.20231 ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE	
Date of mailing (day/month/year) 11 August 1999 (11.08.99)	in its capacity as elected Office	
International application No. PCT/JP99/00225	Applicant's or agent's file reference PCT-0040	
International filing date (day/month/year) 22 January 1999 (22.01.99)	Priority date (day/month/year) 23 January 1998 (23.01.98)	
Applicant VAMAMOTO Koji et al		

Authorized officer

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

Sean Taylor

Form PCT/IB/331 (July 1992)

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

The International Bureau of WIPO

34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland